

トランジスタ



# 2SC4238

## シリコン NPN エピタキシャルプレーナ形

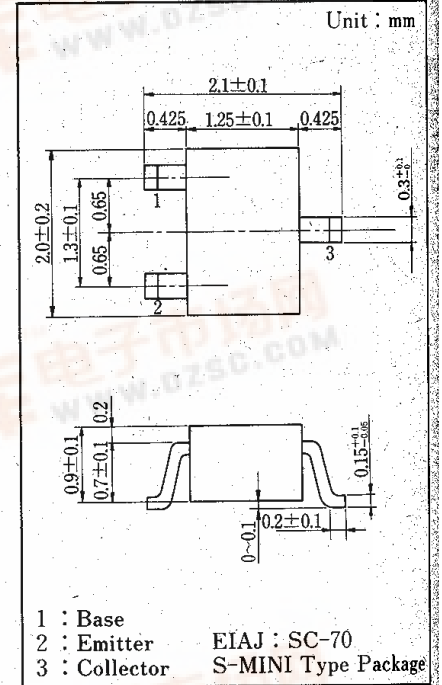
高周波増幅用・発振混合用

### ■ 特長

- 電力利得PGが高い。
- トランジション周波数 $f_T$ が高い。
- Sミニ型パッケージのため機器の小形化およびテーピング、マガジン包装による自動挿入が可能。

### ■ 絶対最大定格 (Ta=25°C)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	$V_{CBO}$	30	V
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CEO}$	15	V
エミッタ・ベース電圧	$V_{EBO}$	3	V
コレクタ電流	$I_C$	50	mA
コレクタ損失	$P_C$	200	mW
接合部温度	$T_j$	150	°C
保存温度	$T_{stg}$	-55~+150	°C



Marking Symbol: 4B

### ■ 電気的特性 (Ta=25°C)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
エミッタシャ断電流	$I_{EBO}$	$V_{EB}=2V, I_C=0$			2	$\mu A$
コレクタ・ベース電圧	$V_{CBO}$	$I_C=100\mu A, I_E=0$	30			V
直流電流増幅率	$h_{FE}$	$V_{CE}=10V, I_C=2mA$	100		350	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=20mA, I_B=4mA$			0.5	V
ベース・エミッタ電圧	$V_{BE}$	$V_{CB}=10V, I_E=-2mA$		0.7		V
トランジション周波数	$f_T$	$V_{CB}=10V, I_E=-15mA, f=200MHz$	0.8	1.3	1.9	GHz
コレクタ出力容量	$C_{ob}$	$V_{CB}=10V, I_E=0, f=1MHz$	0.6	1	1.4	pF
帰還容量	$C_{rb}$	$V_{CB}=6V, I_E=0, f=1MHz$		0.4		pF
電力利得	PG	$V_{CB}=10V, I_E=-10mA, f=200MHz$	14	18	22	dB

### ■ 形名表示記号

